Final datasheet

EasyPACK™ 模块 采用 CoolSiC™ Trench MOSFET 带有 PressFIT 压接管脚和温度检测 NTC

特性


Typical appearance

- 电气特性
  - V_{DSS} = 1200 V
  - I_{DN} = 50 A / I_{DRM} = 100 A
  - 低电感设计
  - 低开关损耗
  - 高电流密度
  - 可以从下面链接寻找适合的英飞凌驱动 IC https://www.infineon.com/gdfinder
- 机械特性
  - PressFIT 压接技术
  - 集成 NTC 温度传感器
  - 集成的安装夹使安装坚固
  - 封装的 CTI > 600
  - 高电流压接管脚

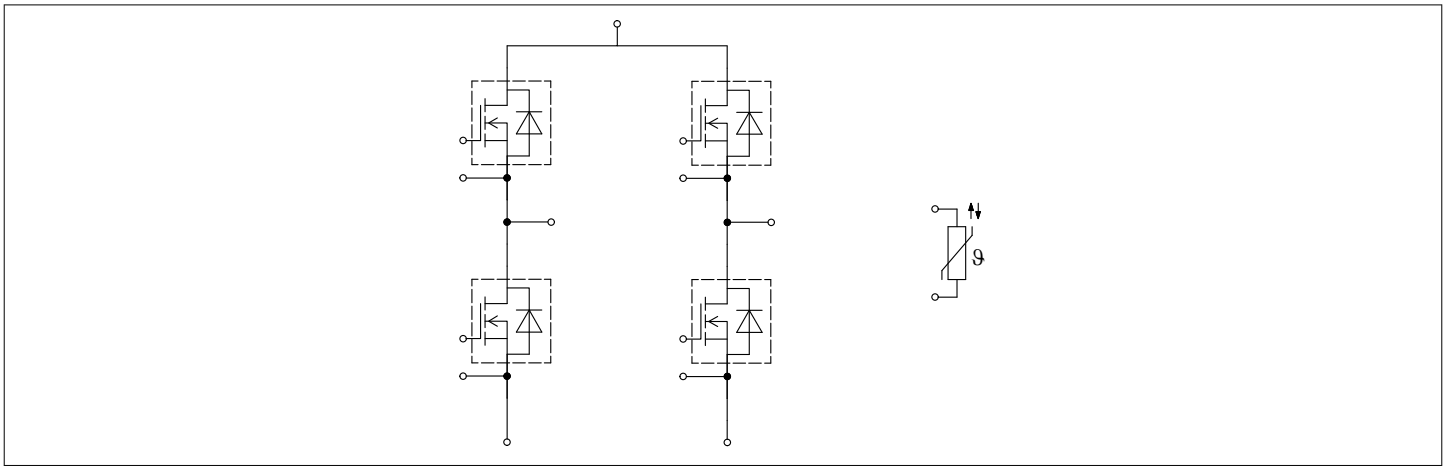
可选应用

- 高频开关应用
- DC/DC 变换器
- 电动车直流充电

产品认证

- 根据 IEC 60747、60749 和 60068 标准的相关测试，符合工业应用的要求。

描述



内容

描述 1
特性 1
可选应用 1
产品认证 1
内容 2
1 封装 3
2 **MOSFET, T1-T4** 3
3 **Body diode (MOSFET, T1-T4)** 5
4 负温度系数热敏电阻 6
5 特征参数图表 7
6 电路拓扑图 13
7 封装尺寸 14
8 模块标签代码 14
修订历史 15
免责声明 16

1 封装

表 1 绝缘参数

特征参数	代号	标注或测试条件	数值	单位
绝缘测试电压	V_{ISOL}	RMS, f = 50 Hz, *t* = 60 s	4.0	kV
NTC 绝缘测试电压	$V_{ISOL(NTC)}$	RMS, f = 50 Hz, *t* = 60 s	3.0	kV
内部绝缘		基本绝缘 (class 1, IEC 61140)	Al_2O_3	
相对电痕指数	*CTI*		> 600	
相对温度指数 (电)	*RTI*	基壳	180	°C
		上盖	150	

表 2 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
杂散电感,模块	L_{sCE}			14		nH
模块引线电阻,端子-芯片	$R_{CC'+EE'}$	T_H = 25 °C, 每个开关		2.6		mΩ
储存温度	T_{stg}		-40		150	°C
Mounting force per clamp	*F*		20		50	N
重量	*G*			24		g

注: The current up to 50A per pin is limited by the interaction of the pins with the PCB design and cooling conditions.

2 MOSFET, T1-T4

表 3 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
漏源极电压	V_{DSS}		T_{vj} = 25 °C	1200	V
植入漏极电流	I_{DN}			50	A
连续漏极直流电流	I_{DDC}	T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = 18 V	T_H = 25 °C	60	A
漏极重复峰值电流	I_{DRM}	verified by design, t_p limited by T_{vjmax}		100	A
栅-源瞬态最大电压	V_{GS}	*D* < 0.01		-10/25	V
栅-源稳态最大电压	V_{GS}			-7/20	V

表 4 推荐值

特征参数	代号	标注或测试条件	[ZH]Values	单位
通态栅极电压	$V_{GS(on)}$		15...18	V
断态栅极电压	$V_{GS(off)}$		-5...0	V

表 5　　特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
漏源通态电阻	$R_{DS(on)}$	I_D = 50 A	V_{GS} = 15 V, T_{vj} = 25 °C		15		mΩ
			V_{GS} = 18 V, T_{vj} = 25 °C		12.5	19.3	
			V_{GS}=18 V, T_{vj}=125 °C		19.4		
			V_{GS}=18 V, T_{vj}=175 °C		25.2		
栅极阈值电压	$V_{GS(th)}$	I_D = 22 mA, V_{DS} = V_{GS}, T_{vj} = 25 °C, (tested after 1ms pulse at V_{GS} = +20 V)		3.45	4.3	5.15	V
栅极电荷	Q_G	V_{DD}=800 V, V_{GS} = -3/18 V, T_{vj} = 25 °C			0.158		µC
内部栅极电阻	R_{Gint}	T_{vj}=25 °C			5.2		Ω
输入电容	C_{ISS}	f = 100 kHz, V_{DS}=800 V, V_{GS}=0 V	T_{vj}=25 °C		4.8		nF
输出电容	C_{OSS}	f = 100 kHz, V_{DS}=800 V, V_{GS}=0 V	T_{vj}=25 °C		0.196		nF
反向传输电容	C_{rss}	f = 100 kHz, V_{DS}=800 V, V_{GS}=0 V	T_{vj}=25 °C		0.013		nF
C_{OSS} 存储能量	E_{OSS}	V_{DS}=800 V, V_{GS} = -3/18 V, T_{vj} = 25 °C			80.4		µJ
漏源泄漏电流	I_{DSS}	V_{DS} = 1200 V, V_{GS} = -3 V	T_{vj} = 25 °C		0.2	208	µA
栅极漏电流	I_{GSS}	V_{DS} = 0 V, T_{vj} = 25 °C	V_{GS}=20 V			400	nA
开通延迟时间(感性负载)	$t_{d\,on}$	I_D = 50 A, R_{Gon} = 4.7 Ω, V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3/18 V, t_{dead} = 1000 ns, 0.1 V_{GS} to 0.1 I_D	T_{vj} = 25 °C		24		ns
			T_{vj} = 125 °C		24		
			T_{vj} = 175 °C		24		
上升时间(感性负载)	t_r	I_D = 50 A, R_{Gon} = 4.7 Ω, V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3/18 V, t_{dead} = 1000 ns, 0.1 I_D to 0.9 I_D	T_{vj} = 25 °C		12		ns
			T_{vj} = 125 °C		11		
			T_{vj} = 175 °C		11		
关断延迟时间(感性负载)	$t_{d\,off}$	I_D = 50 A, R_{Goff} = 0.22 Ω, V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3/18 V, 0.9 V_{GS} to 0.9 I_D	T_{vj} = 25 °C		39		ns
			T_{vj} = 125 °C		46		
			T_{vj} = 175 °C		48		

(待续)

表 5 (续) 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
下降时间(感性负载)	t_f	I_D = 50 A, R_{Goff} = 0.22 Ω, V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3/18 V, 0.9 I_D to 0.1 I_D	T_{vj} = 25 °C		14		ns
			T_{vj} = 125 °C		16		
			T_{vj} = 175 °C		16		
开通损耗能量 (每脉冲)	E_{on}	I_D = 50 A, V_{DD} = 800 V, L_σ = 15 nH, V_{GS} = -3/18 V, R_{Gon} = 4.7 Ω, di/dt = 5.17 kA/µs (T_{vj} = 175 °C), t_{dead} = 1000 ns	T_{vj} = 25 °C		0.95		mJ
			T_{vj} = 125 °C		1.14		
			T_{vj} = 175 °C		1.31		
开通损耗能量 (每脉冲), 优化条件下	$E_{on,o}$	I_D = 50 A, V_{DD} = 800 V, L_σ = 15 nH, V_{GS} = -3/15 V, $R_{Gon,o}$ = 0.22 Ω, di/dt = 9.15 kA/µs (T_{vj} = 175 °C), t_{dead}=100 ns	T_{vj} = 25 °C		0.52		mJ
			T_{vj} = 125 °C		0.52		
			T_{vj} = 175 °C		0.57		
关断损耗能量 (每脉冲）	E_{off}	I_D = 50 A, V_{DD} = 800 V, L_σ = 15 nH, V_{GS} = -3/18 V, R_{Goff} = 0.22 Ω, dv/dt = 41.8 kV/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		0.27		mJ
			T_{vj} = 125 °C		0.31		
			T_{vj} = 175 °C		0.34		
结－散热器热阻	R_{thJH}	每个 MOSFET , λ_{grease} = 5 W/(m·K)			0.994		K/W
允许开关的温度范围	$T_{vj\,op}$			-40		175	°C
过载运行条件下的温度	$T_{vj\,over}$	过载工况， 累计最大 100 小时				200	°C

注: The selection of positive and negative gate-source voltages impacts losses and the long-term behavior of the MOSFET and body diode. The design guidelines described in Application Notes AN 2018-09 and AN 2025-02 must be considered to ensure sound operation of the device over the planned lifetime.

3 Body diode (MOSFET, T1-T4)

表 6 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
体二极管正向直流电流	I_{SD}	T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = -3 V	T_H = 25 °C	30	A
Pulsed body diode current	$I_{SD\,pulse}$			100	A

表 7 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
正向电压	V_{SD}	I_{SD} = 50 A, V_{GS} = -3 V	T_{vj} = 25 °C		4.35	5.35	V
			T_{vj} = 125 °C		4.05		
			T_{vj} = 175 °C		3.9		
反向恢复峰值电流	I_{rrm}	I_{SD} = 50 A, di_s/dt = 5.17 kA/µs, V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3 V, t_{dead} = 1000 ns	T_{vj} = 25 °C		43.1		A
			T_{vj} = 125 °C		58.7		
			T_{vj} = 175 °C		70.7		
恢复电荷	Q_{rr}	I_{SD} = 50 A, di_s/dt = 5.17 kA/µs, V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3 V, t_{dead} = 1000 ns	T_{vj} = 25 °C		0.45		µC
			T_{vj} = 125 °C		0.88		
			T_{vj} = 175 °C		1.21		
反向恢复损耗（每脉冲）	E_{rec}	I_{SD} = 50 A, di_s/dt = 5.17 kA/µs (T_{vj} = 175 °C), V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3 V, t_{dead} = 1000 ns	T_{vj} = 25 °C		0.12		mJ
			T_{vj} = 125 °C		0.34		
			T_{vj} = 175 °C		0.41		
反向恢复损耗（每脉冲），优化条件下	$E_{rec,o}$	I_{SD} = 50 A, di_s/dt = 9.15 kA/µs (T_{vj} = 175 °C), V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3/18 V, t_{dead} = 100 ns	T_{vj} = 25 °C		0.19		mJ
			T_{vj} = 125 °C		0.21		
			T_{vj} = 175 °C		0.25		

4 负温度系数热敏电阻

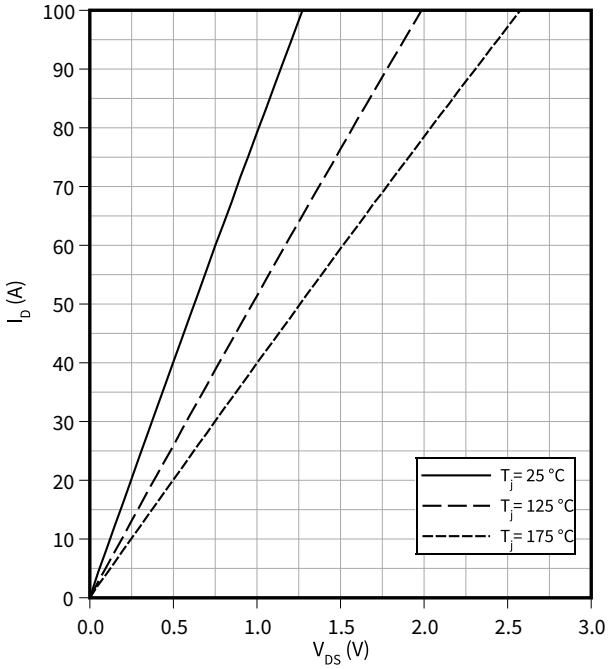
表 8 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
额定电阻值	R_{25}	T_{NTC} = 25 °C		5		kΩ
R_{100} 偏差	$\Delta R/R$	T_{NTC} = 100 °C, R_{100} = 493 Ω	-5		5	%
耗散功率	P_{25}	T_{NTC} = 25 °C			20	mW
B-值	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2-1/(298{,}15\ K))]$		3375		K
B-值	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2-1/(298{,}15\ K))]$		3411		K
B-值	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2-1/(298{,}15\ K))]$		3433		K

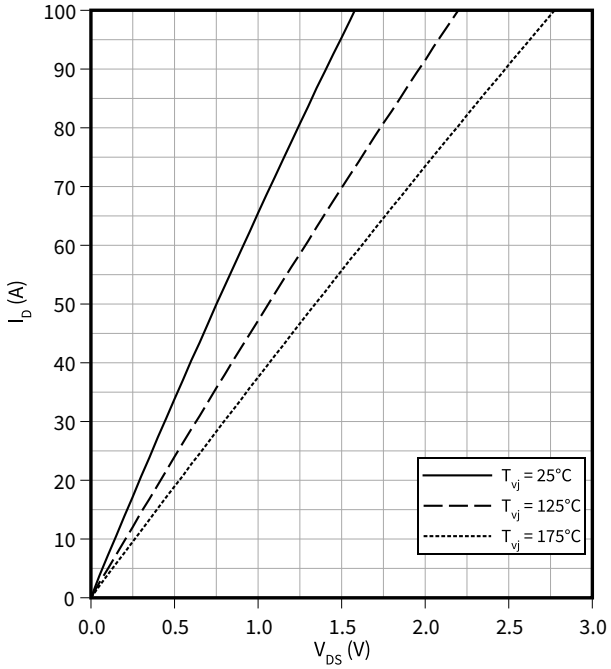
注: NTC 的具体参数分析请见 AN2009-10, 第 4 章

5 特征参数图表

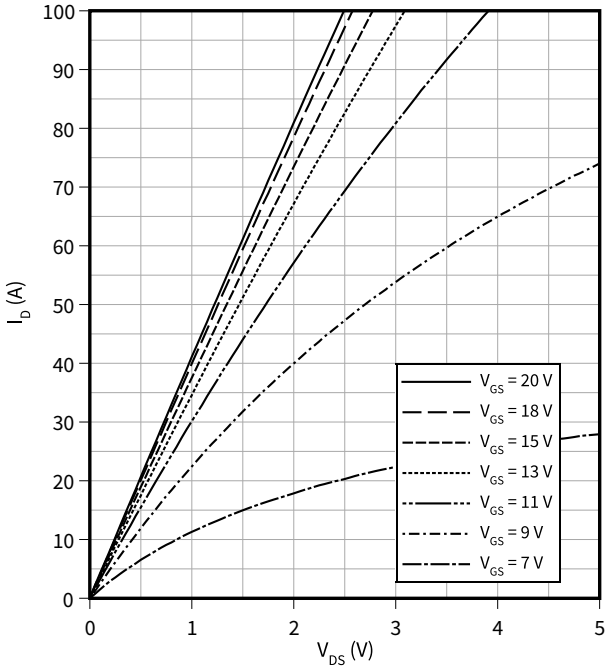
输出特性 （典型), MOSFET, T1-T4
$I_D = f(V_{DS})$
V_{GS} = 18 V



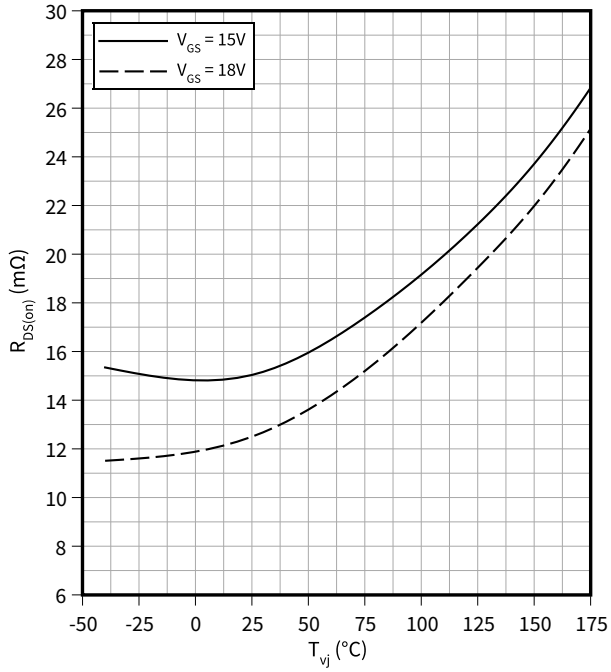
输出特性 （典型), MOSFET, T1-T4
$I_D = f(V_{DS})$
V_{GS} = 15 V



输出特性 （典型), MOSFET, T1-T4
$I_D = f(V_{DS})$
T_{vj} = 175 °C

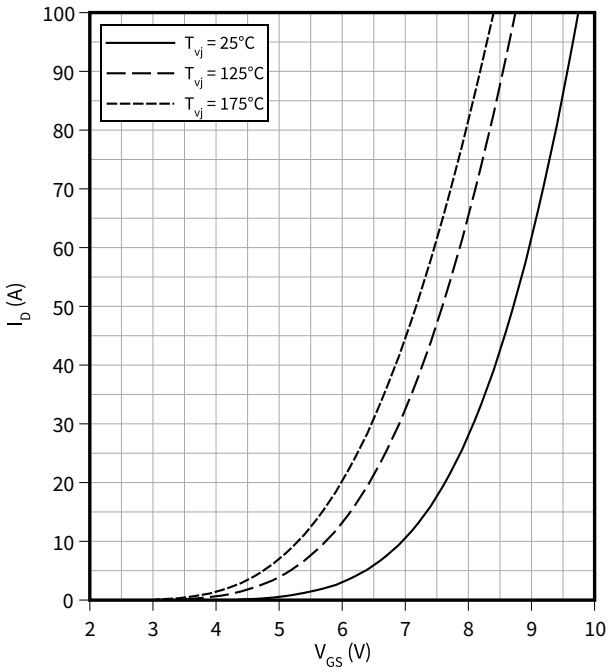


漏源通态电阻 （典型), MOSFET, T1-T4
$R_{DS(on)} = f(T_{vj})$
I_D = 50 A



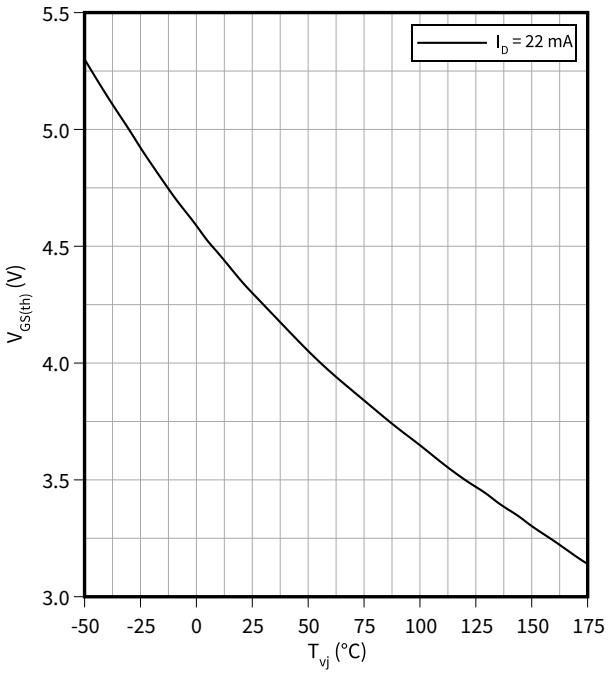
传输特性 （典型), MOSFET, T1-T4

$I_D = f(V_{GS})$
$V_{DS} = 20\ V$



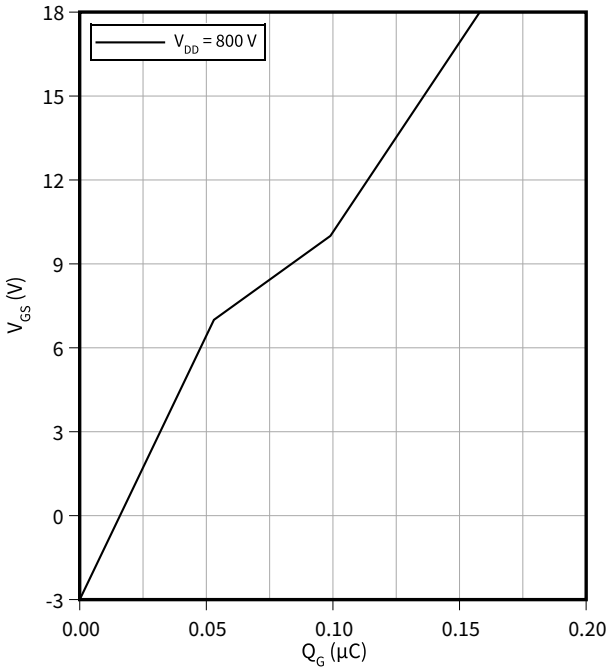
栅-源阀值电压（典型）, MOSFET, T1-T4

$V_{GS(th)} = f(T_{vj})$
$V_{GS} = V_{DS}$



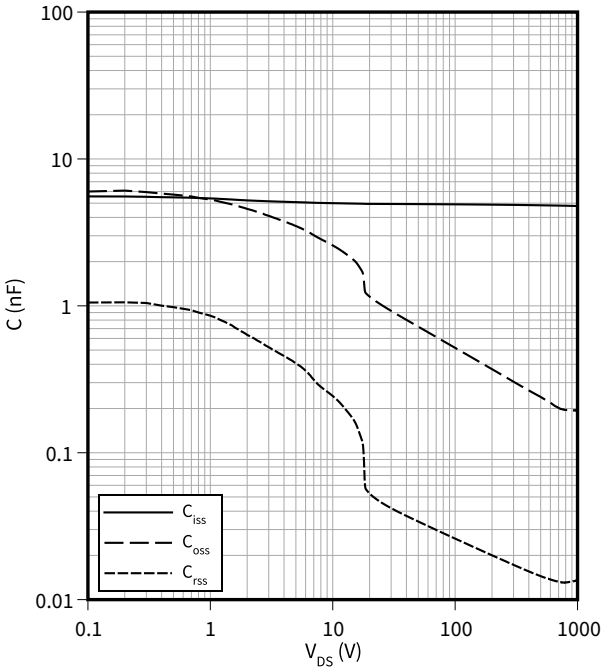
栅极电荷特性 （典型), MOSFET, T1-T4

$V_{GS} = f(Q_G)$
$I_D = 50\ A$, $T_{vj} = 25\ °C$



电容特性 （典型), MOSFET, T1-T4

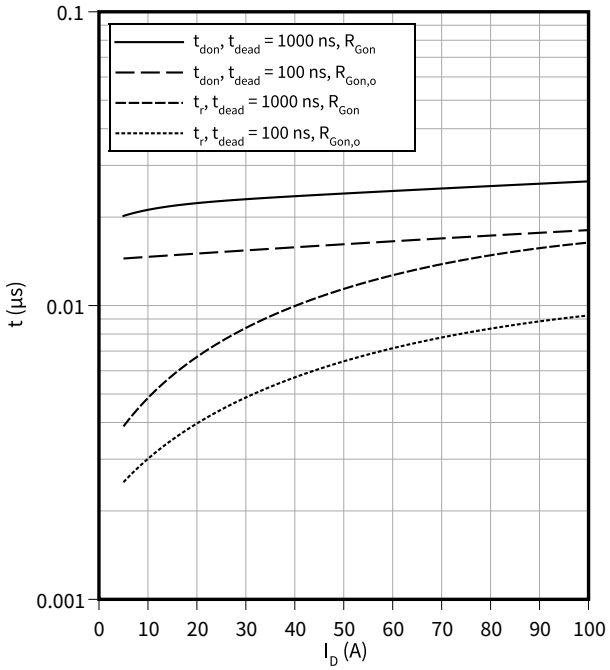
$C = f(V_{DS})$
$f = 100\ kHz$, $T_{vj} = 25\ °C$, $V_{GS} = 0\ V$



开关时间 （典型), MOSFET, T1-T4

$t = f(I_D)$

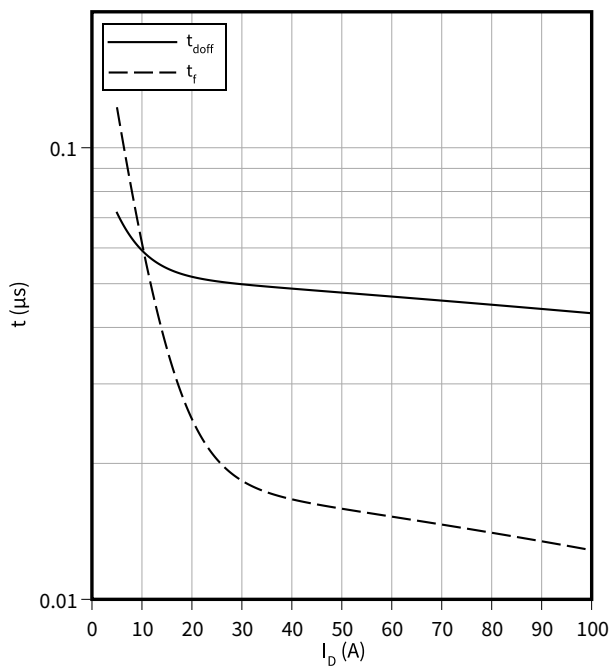
$R_{Gon} = 4.7\ \Omega$, $V_{DD} = 800$ V, $R_{Gon,o} = 0.22\ \Omega$, $T_{vj} = 175$ °C, $V_{GS} = -3/18$ V



开关时间 （典型), MOSFET, T1-T4

$t = f(I_D)$

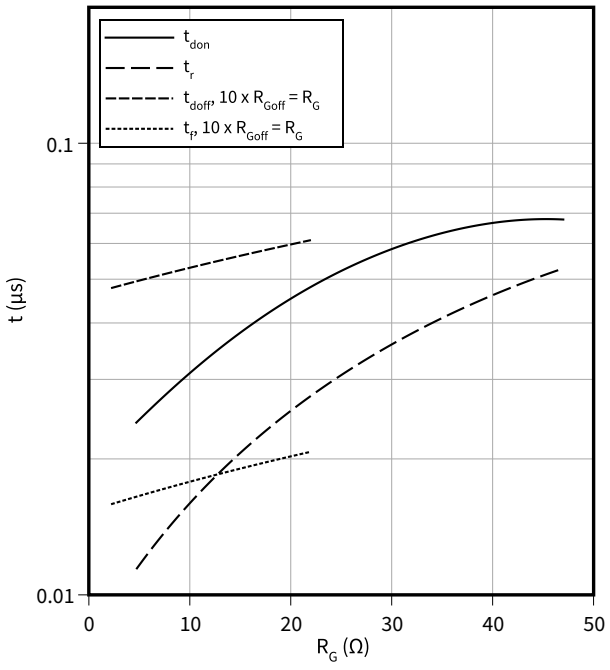
$R_{Goff} = 0.22\ \Omega$, $V_{DD} = 800$ V, $T_{vj} = 175$ °C, $V_{GS} = -3/18$ V



开关时间 （典型), MOSFET, T1-T4

$t = f(R_G)$

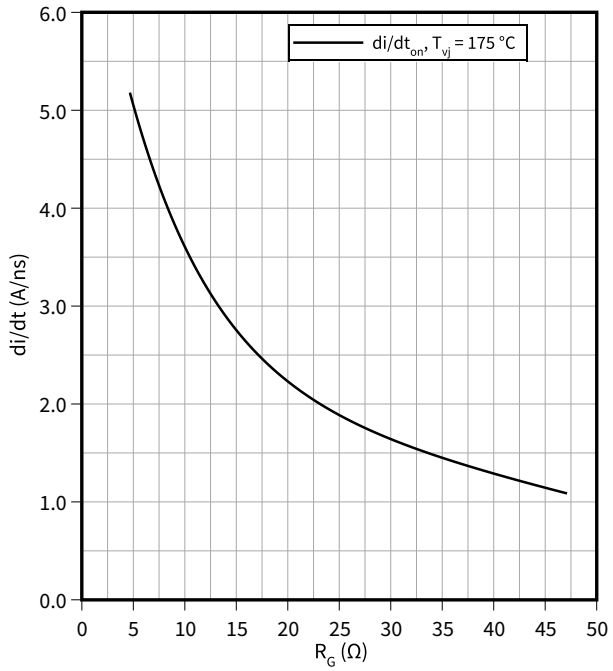
$V_{DD} = 800$ V, $t_{dead} = 1000$ ns, $I_D = 50$ A, $T_{vj} = 175$ °C, $V_{GS} = -3/18$ V



电流变化斜率 （典型), MOSFET, T1-T4

$di/dt = f(R_G)$

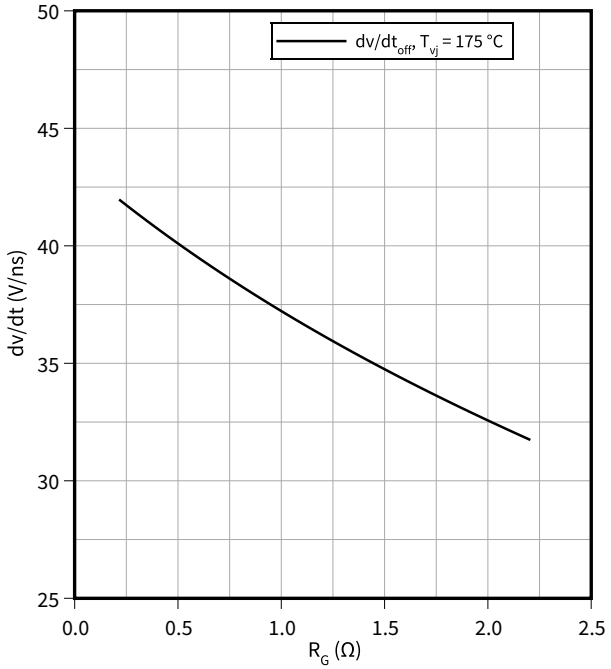
$V_{DD} = 800$ V, $t_{dead} = 1000$ ns, $I_D = 50$ A, $V_{GS} = -3/18$ V



电压变化斜率 （典型), MOSFET, T1-T4

$dv/dt = f(R_G)$

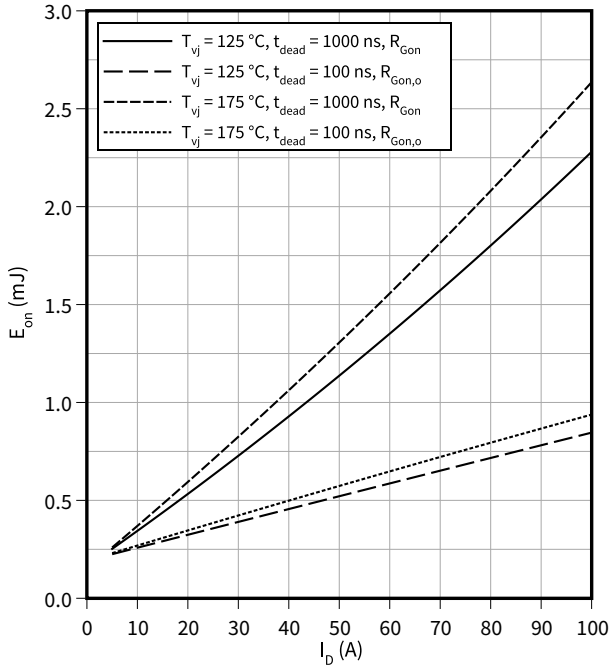
V_{DD} = 800 V, I_D = 50 A, V_{GS} = -3/18 V



开关损耗 （典型), MOSFET, T1-T4

$E_{on} = f(I_D)$

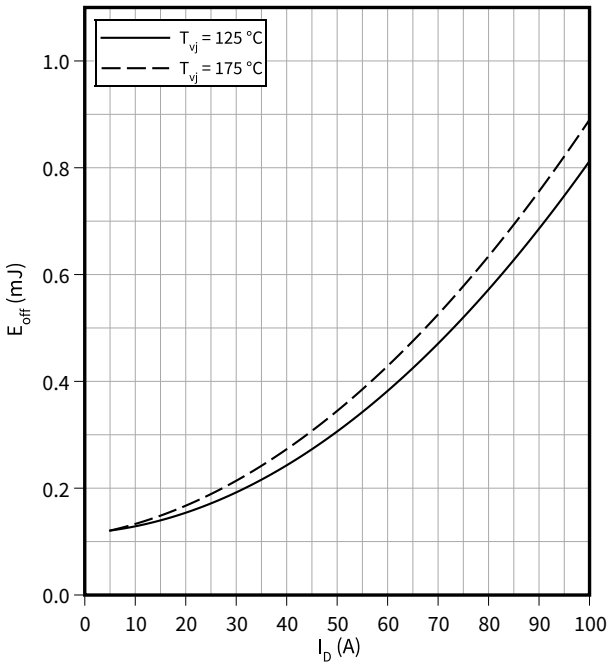
R_{Gon} = 4.7 Ω, V_{DD} = 800 V, $R_{Gon,o}$ = 0.22 Ω, V_{GS} = -3/18 V



开关损耗 （典型), MOSFET, T1-T4

$E_{off} = f(I_D)$

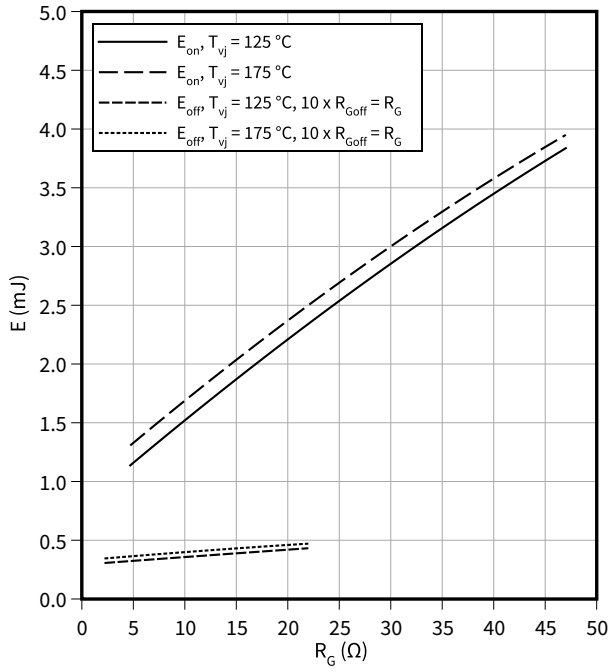
R_{Goff} = 0.22 Ω, V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3/18 V



开关损耗 （典型), MOSFET, T1-T4

$E = f(R_G)$

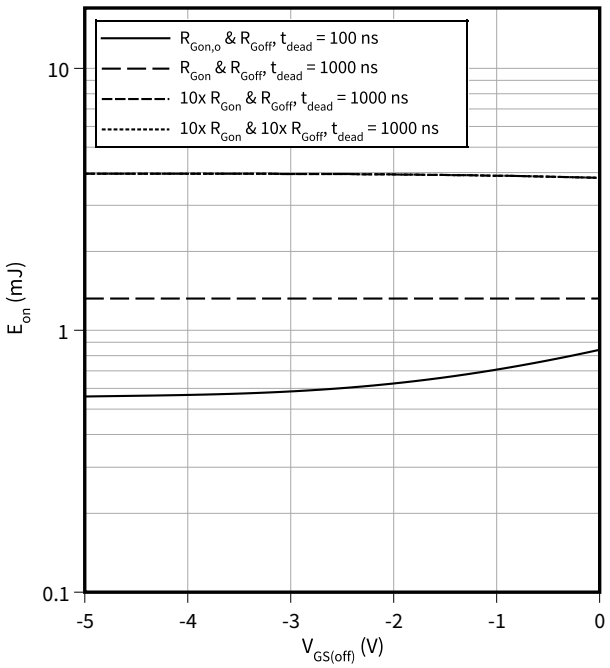
V_{DD} = 800 V, t_{dead} = 1000 ns, I_D = 50 A, V_{GS} = -3/18 V



开关损耗 （典型), MOSFET, T1-T4

$E_{on} = f(V_{GS(off)})$

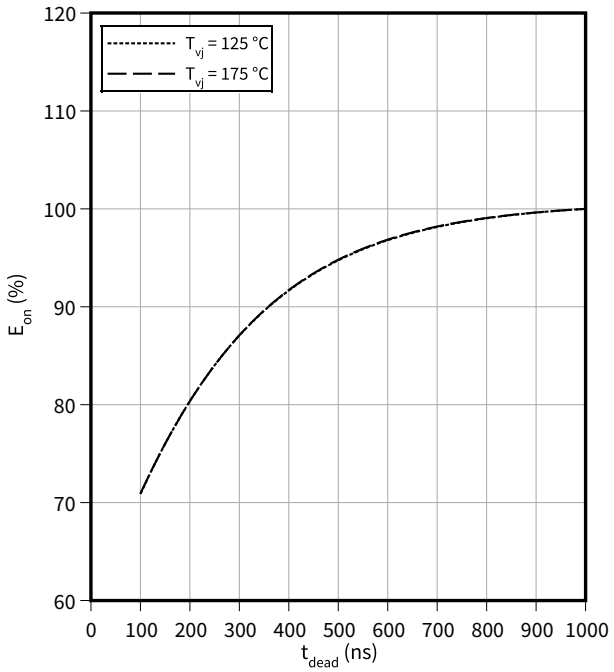
$R_{Goff} = 0.22\ \Omega$, $V_{DD} = 800$ V, $R_{Gon} = 4.7\ \Omega$, $I_D = 50$ A, $V_{GS(on)} = 18$ V, $R_{Gon,o} = 0.22\ \Omega$, $T_{vj} = 175$ °C



开关损耗 （典型), MOSFET, T1-T4

$E_{on} = f(t_{dead})$

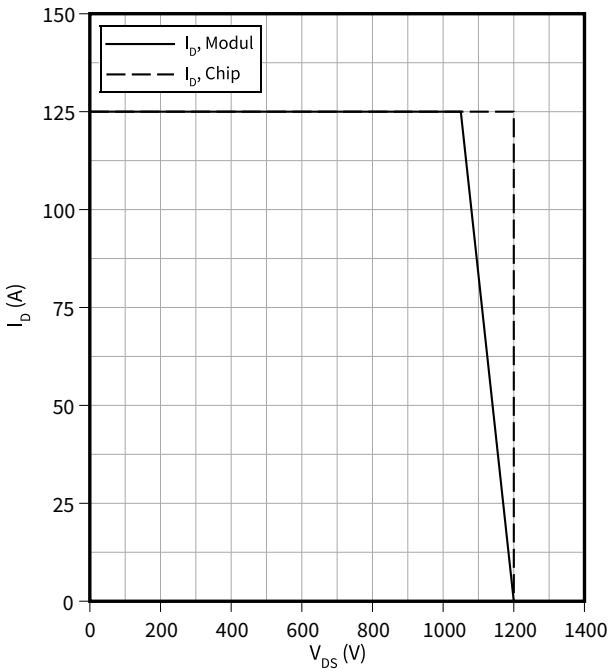
$R_{Gon} = 4.7\ \Omega$, $I_D = 50$ A, $V_{DD} = 800$ V, $V_{GS} = -3/18$ V



反偏安全工作区 （RBSOA）, MOSFET, T1-T4

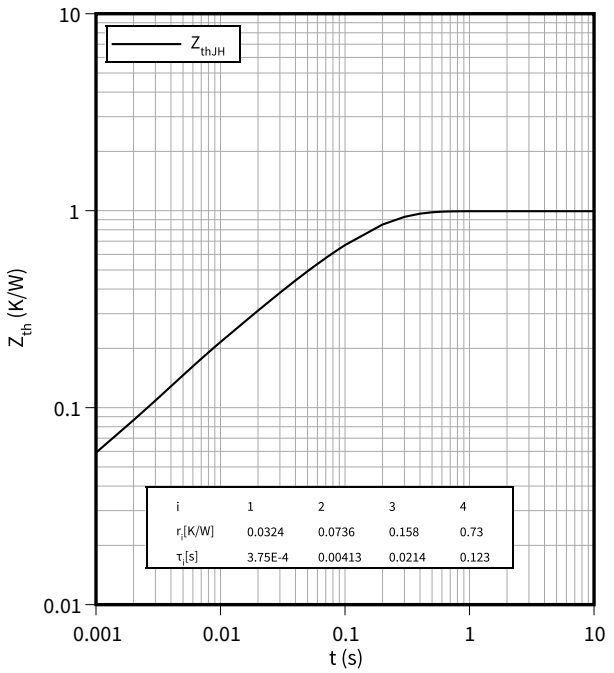
$I_D = f(V_{DS})$

$R_{Goff} = 0.22\ \Omega$, $T_{vj} = 175$ °C, $V_{GS} = -3/18$ V



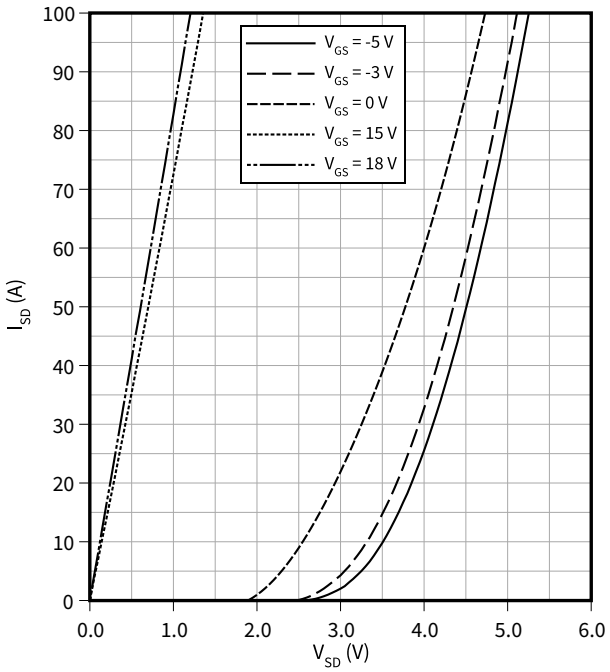
瞬态热阻抗, MOSFET, T1-T4

$Z_{th} = f(t)$



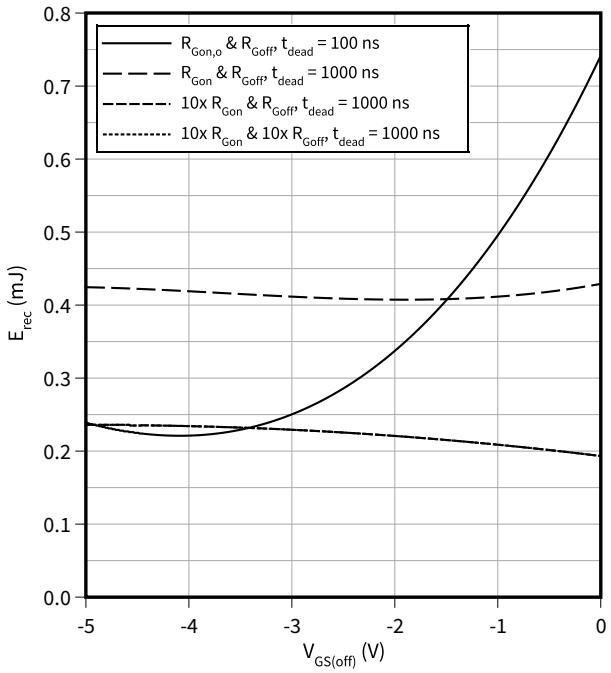
正向特性 体二极管（典型), MOSFET, T1-T4

$I_{SD} = f(V_{SD})$
$T_{vj} = 25\ °C$



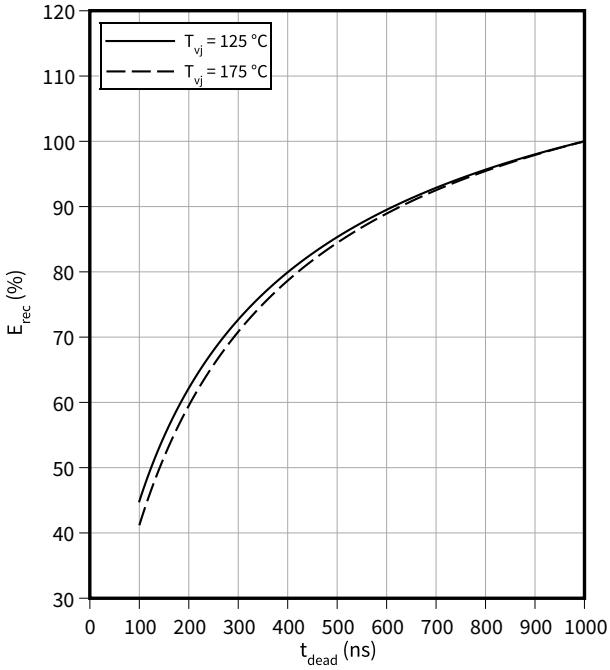
开关损耗 体二极管（典型), MOSFET, T1-T4

$E_{rec} = f(V_{GS(off)})$
$R_{Goff} = 0.22\ \Omega$, $R_{Gon} = 4.7\ \Omega$, $V_{GS(on)} = 18\ V$, $I_{SD} = 50\ A$,
$R_{Gon,o} = 0.22\ \Omega$, $V_{DD} = 800\ V$, $T_{vj} = 175\ °C$



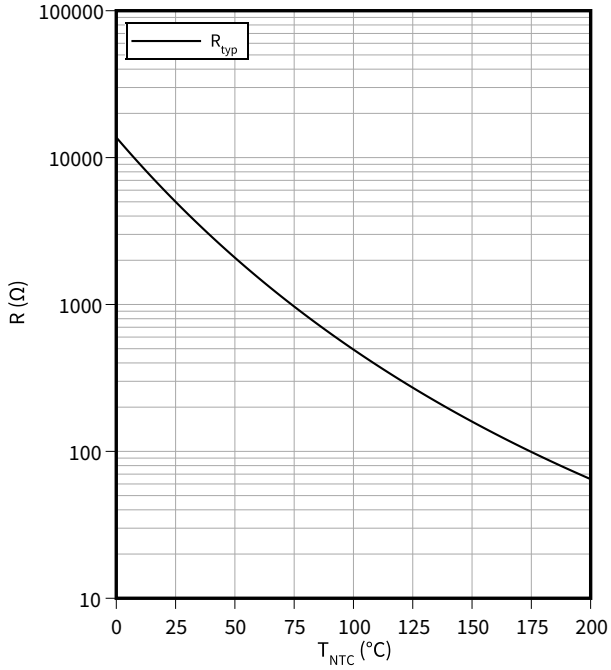
开关损耗 体二极管（典型), MOSFET, T1-T4

$E_{rec} = f(t_{dead})$
$R_{Gon} = 4.7\ \Omega$, $I_D = 50\ A$, $V_{DD} = 800\ V$, $V_{GS} = -3/18\ V$



温度特性, 负温度系数热敏电阻

$R = f(T_{NTC})$



6 电路拓扑图

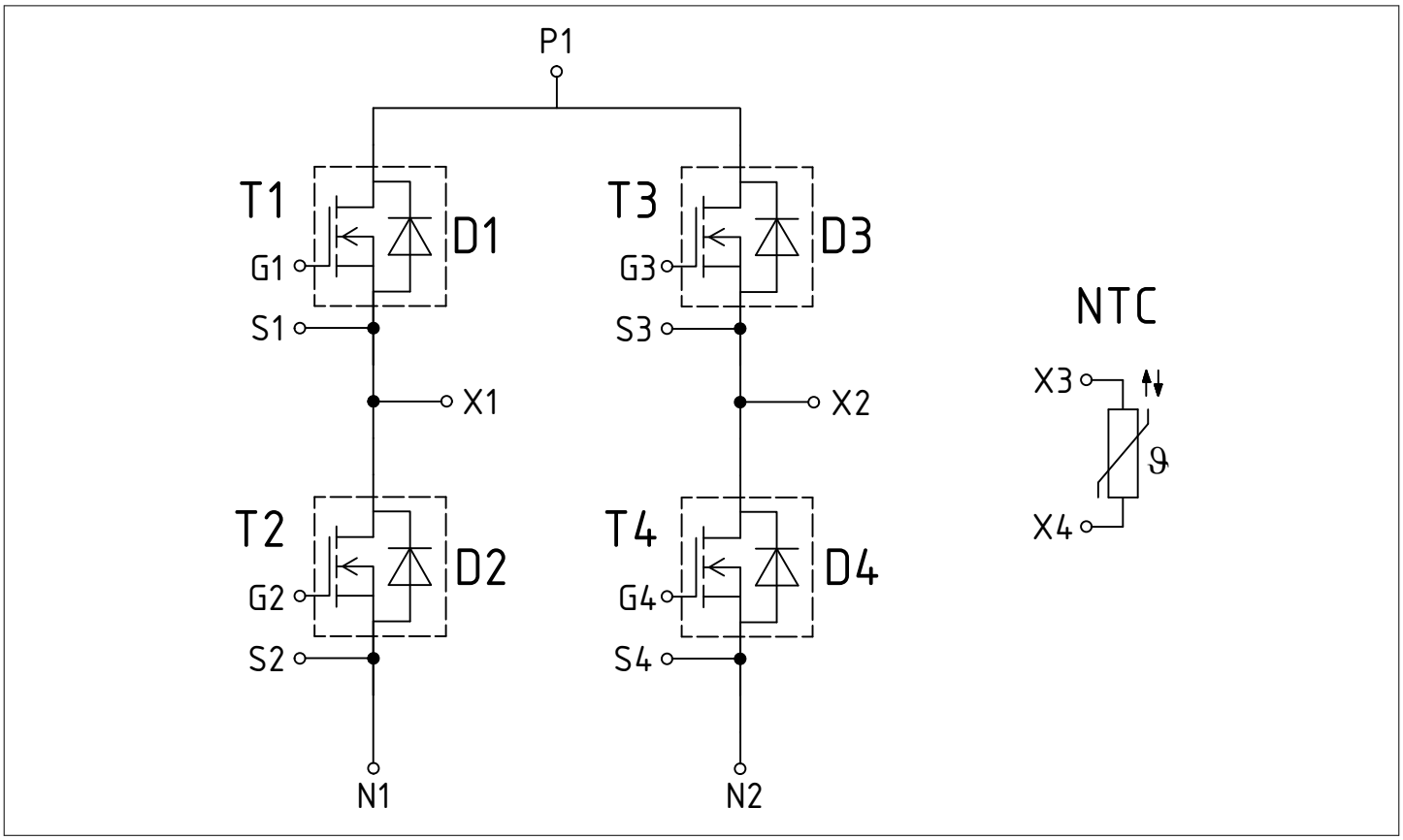


图 1

7 封装尺寸

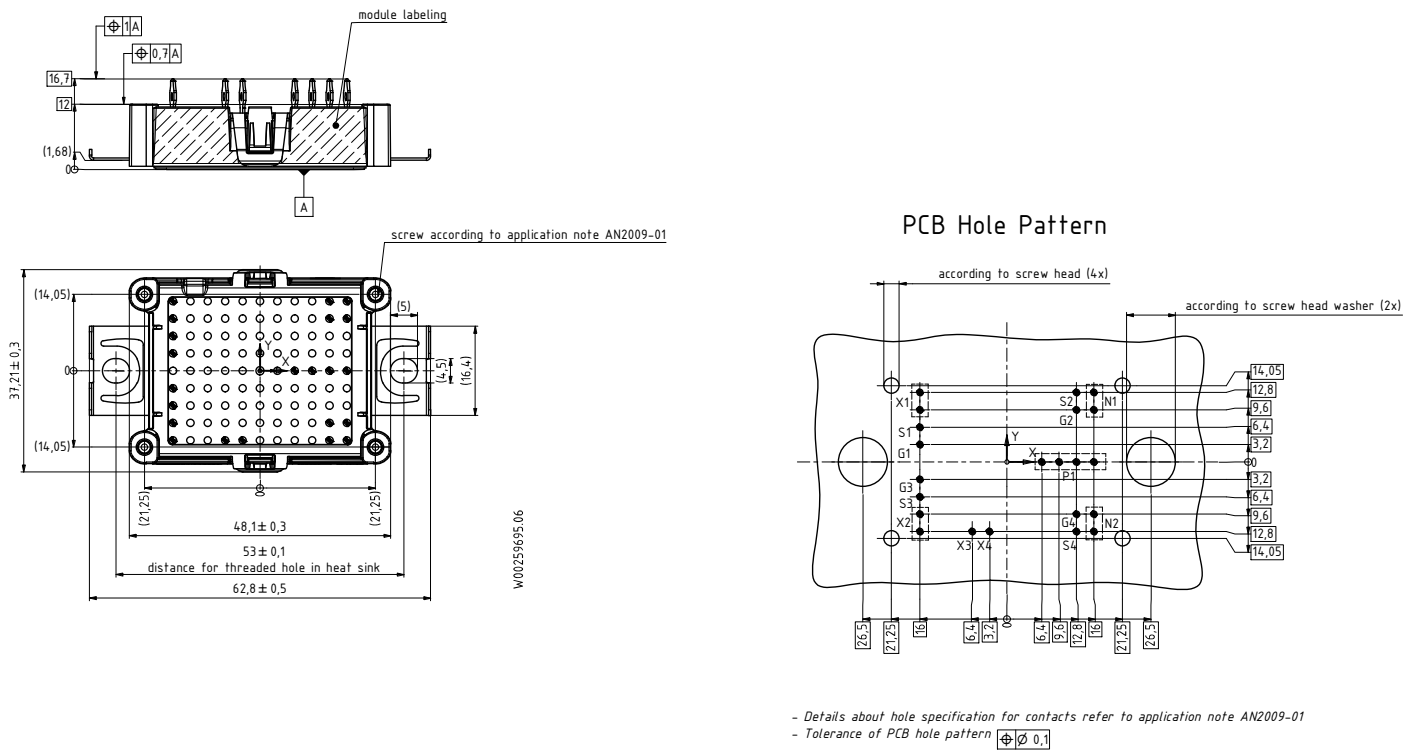


图 2

8 模块标签代码

Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	*Content* Module serial number Module material number Production order number Date code (production year) Date code (production week)	*Digit* 1 –5 6 - 11 12 - 19 20 –21 22 –23	*Example* 71549 142846 55054991 15 30
Example	7154914284655054991530		7154914284655054991530

图 3

修订历史

修订版本	发布日期	变更说明
0.10	2024-11-12	Initial version
0.20	2025-07-02	Preliminary datasheet
1.00	2026-03-02	Final datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2026-03-02

Published by

Infineon Technologies AG

81726 Munich, Germany

© 2026 Infineon Technologies AG

All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-ABK171-003

重要提示

本文档所提供的任何信息绝不应当被视为针对任何 条件或者品质而做出的保证（质量保证）。

英飞凌对于本文档中所提及的任何事例、提示或者 任何特定数值及/或任何关于产品应用方面的信息均 在此明确声明其不承担任何保证或者责任，包括但 不限于其不侵犯任何第三方知识产权的保证均在此 排除。

此外，本文档所提供的任何信息均取决于客户履行 本文档所载明的义务和客户遵守适用于客户产品以 及与客户对于英飞凌产品的应用所相关的任何法律 要求、规范和标准。

本文档所含的数据仅供经过专业技术培训的人员使用。客户自身的技术部门有义务对于产品是否适宜 于其预期的应用和针对该等应用而言本文档中所提 供的信息是否充分自行予以评估。

警告事项

由于技术所需产品可能含有危险物质。如需了解该 等物质的类型，请向离您最近的英飞凌科技办公室 接洽。

除非由经英飞凌科技授权代表签署的书面文件中做 出另行明确批准的情况外，英飞凌科技的产品不应 当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后 当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后 领域。